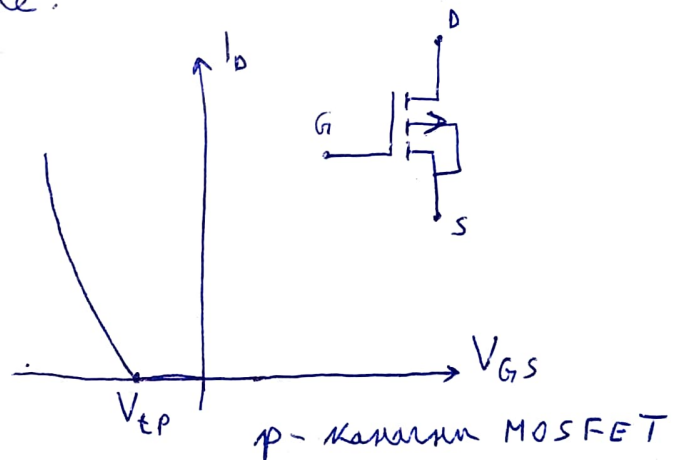
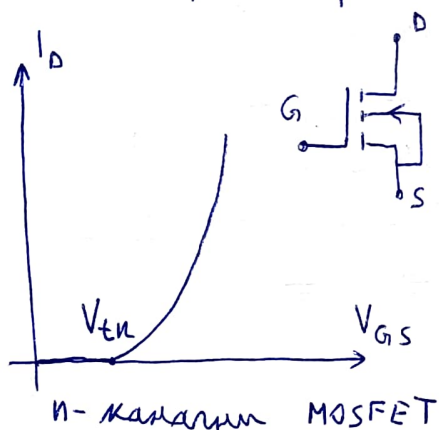
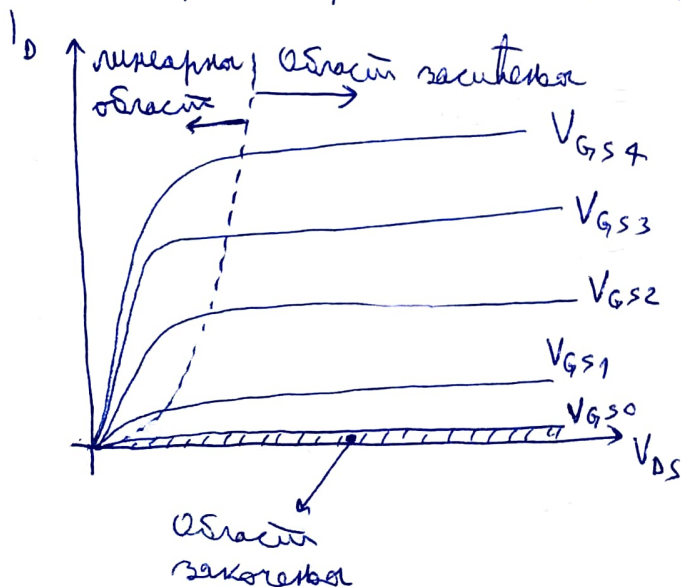


MOS ТРАНЗИСТОРЫ (MOSFET)

- Существует 2 типа MOS транзистора: с индуцированным каналом и с индуцированным каналом. Анализировать транзисторы с индуцированным каналом.
- Преносные характеристики:



- Выходная характеристика n-канального MOS транзистора:



$$V_{GS4} > V_{GS3} > \dots > V_{GS0}$$

- Постоје 3 режима рада:

1° Режим закривања (cut-off)

$$V_{GS} < V_{th} \Rightarrow I_D = 0$$

2° Линеарна (триодна) област

$$V_{GS} > V_{th}, \quad V_{DS} < V_{GS} - V_{th}$$

$$I_D = \beta_n \left[(V_{GS} - V_{th}) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$$

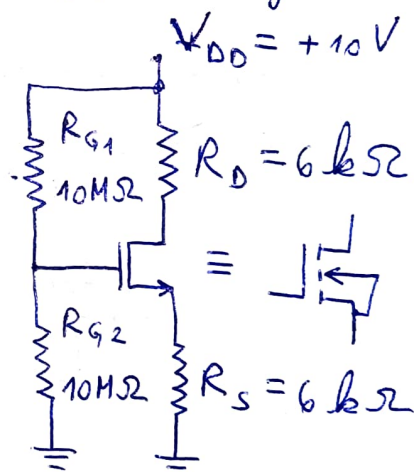
3° Област засићења

$$V_{GS} > V_{th}, \quad V_{DS} > V_{GS} - V_{th}$$

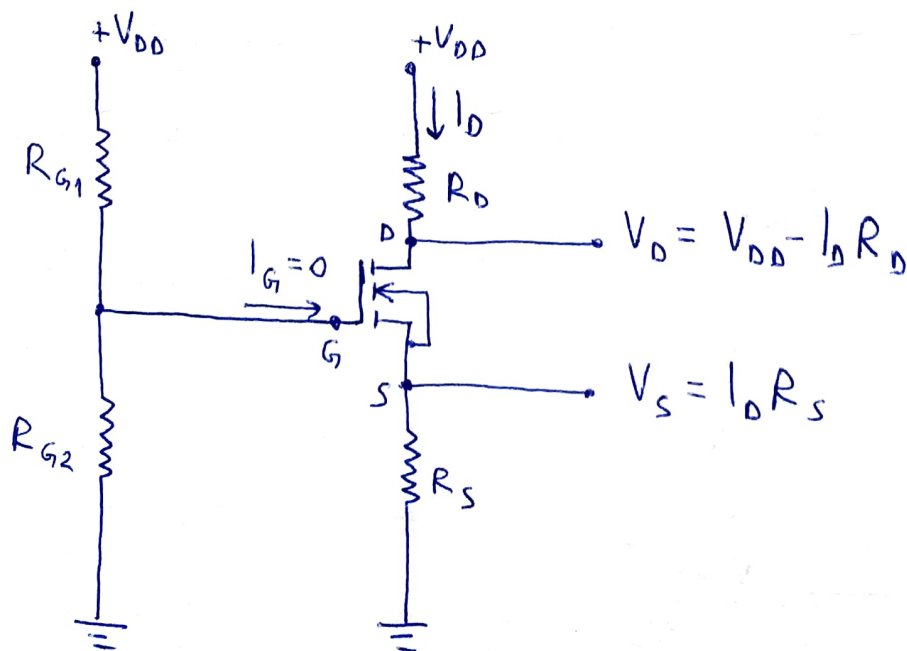
$$I_D = \frac{1}{2} \beta_n (V_{GS} - V_{th})^2$$

19) Анализирајте кџ са слике. Познато је:

$$V_{th} = 1V, \quad \beta_n = 1 \frac{mA}{V^2}$$



Решење:



$$V_G = V_{DD} \frac{R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} = 10 \frac{10 \cdot 10^6}{10 \cdot 10^6 + 10 \cdot 10^6} = \underline{5 V}$$

- Напон на излазу је $+5 V$, што значи да је транзистор укључен, али не знамо у којој области ради (засићене или линеарна област).

- Претпоставимо да је транзистор у засићеном:

$$V_G = 5 V$$

$$V_S = I_D [mA] \cdot 6 [k\Omega] = 6 I_D$$

$$V_{GS} = V_G - V_S = 5 - 6 I_D$$

$$I_D = \frac{1}{2} \beta_n (V_{GS} - V_{th})^2 = \frac{1}{2} \cdot 1 \left[\frac{mA}{V^2} \right] \cdot (5 - 6 I_D - 1)^2$$

$$I_D = \frac{1}{2} (16 - 48 I_D + 36 I_D^2) \Rightarrow 18 I_D^2 - 25 I_D + 8 = 0$$

$$I_D = \begin{cases} 0,89 \text{ mA} \\ 0,5 \text{ mA} \end{cases}$$

- Сада требамо проверити које решење за струју I_D је тачно:

- За $I_D = 0,89 \text{ mA}$:

$$V_S = I_D R_S = 0,89 [mA] \cdot 6 [k\Omega] = 5,34 V > V_G$$

Ово решење нема смисла, јер би било $V_{GS} < 0$, што би значило да је транзистор искључен.

- За $I_D = 0,5 \text{ mA}$:

$$V_S = I_D R_S = 3 V$$

$$V_{GS} = V_G - V_S = 5 - 3 = 2 V > V_{th}$$

$$V_D = V_{DD} - I_D R_D = 10 - 6 \cdot 0,5 = 7 V$$

$$V_{DS} = V_D - V_S = 7 - 3 = 4 V$$

Када имамо истуржљива оба услова да се транзистор налази у заситеној области:

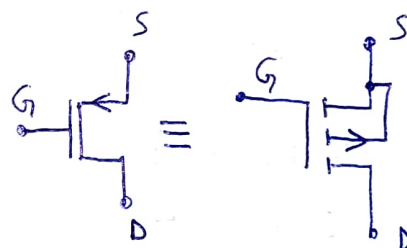
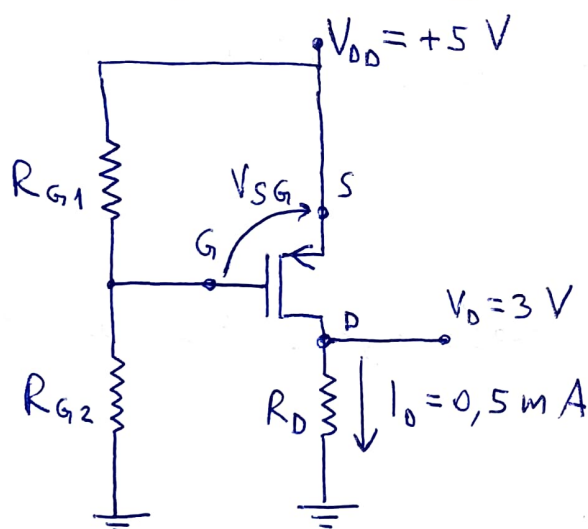
$$V_{GS} > V_{th}$$

$$V_{DS} > V_{GS} - V_{th}$$

Унајуће то у буду, нама представља је марна.

② Пројектовати коло на слици тако да транзистор ради у области заситења и то у режиму марке $I_D = 0,5 \text{ mA}$ и $V_D = 3 \text{ V}$. Познато је $V_{tp} = -1 \text{ V}$, $\beta_p = 1 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}$.

Колка је максимална вредност за R_D , а да транзистор остане у заситеној?



Решење:

За област заситења важи:

$$I_D = \frac{1}{2} \beta_p (V_{SG} - |V_{tp}|)^2$$

$$0,5 \cdot 10^{-3} = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 10^{-3} (V_{SG} - |V_{tp}|)^2$$

$$1 = (V_{SG} - |V_{tp}|)^2 \Rightarrow V_{SG} - |V_{tp}| = 1 \text{ V}$$

$$1 = V_{SG} - 1 \Rightarrow \boxed{V_{SG} = 2 \text{ V}}$$

$$V_G = V_S - V_{SG} = V_{DD} - V_{SG} = 5 - 2 = 3 \text{ V}$$

$$V_G = V_{DD} \frac{R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}}$$

- Моїтьте каніфукація з R_{G1} н R_{G2} :

$$R_{G1} = 2 \text{ M}\Omega, \quad R_{G2} = 3 \text{ M}\Omega$$

$$R_D = \frac{V_D}{I_D} = \frac{3}{0,5 \cdot 10^{-3}} = 6 \text{ k}\Omega$$

- Умов зя се імпансують паразн у зачитеної обрату:

$$\cancel{V_{SG}} V_{SG} > |V_{tp}|, \quad V_{SD} > V_{SG} - |V_{tp}|$$

$$V_{SD} > V_{SG} - |V_{tp}|; \quad V_{SG} = V_{DD} - V_G$$

$$V_{SD} = V_{DD} - V_D$$

$$V_{DD} - V_D > V_{DD} - V_G - |V_{tp}|$$

$$-V_D > -V_G - |V_{tp}| \quad / \cdot (-1)$$

$$V_D < V_G + |V_{tp}| \Rightarrow V_{Dmax} = V_G + |V_{tp}| = 4 \text{ V}$$

$$R_{Dmax} = \frac{V_{Dmax}}{I_D} = \frac{4}{0,5 \cdot 10^{-3}} = \underline{8 \text{ k}\Omega}$$